

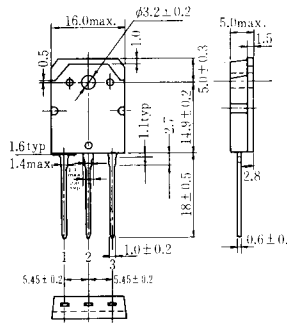
2SD1494

シリコン NPN 三重拡散形

高電圧電力スイッチング用
水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(TO-3P)

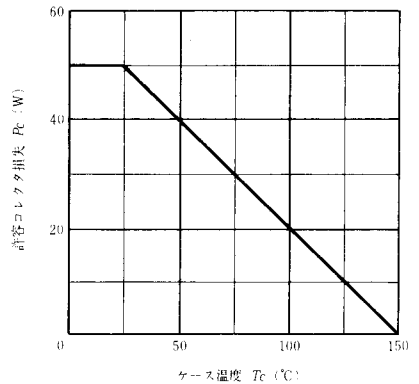
1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD1494	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	3	A
ピークコレクタ電流	$I_{C(surge)}$	6	A
許容コレクタ損失	P_C^*	50	W
合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $T_a = 25^\circ\text{C}$ における許容値。
at $T_c = 25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{mA}$, $R_{BF} = \infty$	800	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10\text{mA}$, $I_C = 0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CE} = 600\text{V}$, $I_E = 0$	—	—	10	μA
	I_{CBX}	$V_{CB} = 1500\text{V}$, $V_{EB} = 1.5\text{V}$	—	—	0.5	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2.5\text{A}$, $I_B = 0.8\text{A}$	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 2.5\text{A}$, $I_B = 0.8\text{A}$	0.8	—	1.5	V
下降時間	t_f	$I_C = 2.75\text{A}$, $I_{B1} = 0.6\text{A}$, $I_{B2} = -1.3\text{A}$, $L = 0$	—	—	1.0	μs